

ПРИСТРІЙ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ Ga, In I Pb

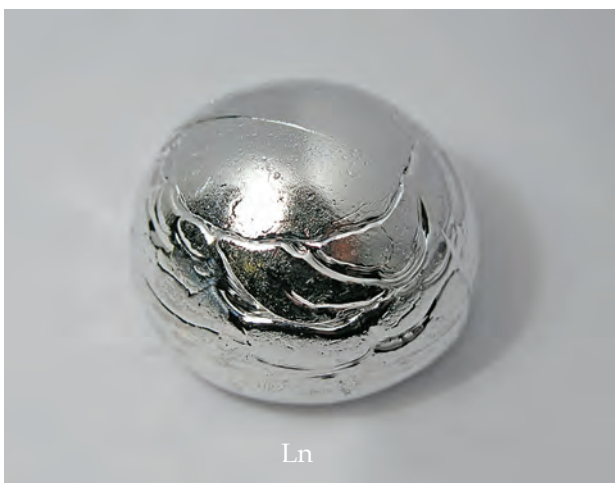


Призначення

Для синтезу матеріалів мікроелектроніки та оптоелектроніки

Характеристики

Маса початкового завантаження матеріалу, кг	2,3
Вихід продукту, % початкового завантаження	90
Продуктивність пристрою, г/год	300 – 400
Робоча температура, °С	950 – 1350
Чистота, %	99,9 – 99,9... >99,999 – 99,9999



Переваги

Унікальне для України обладнання. Глибоке очищення від широкого спектра домішкових елементів. Висока продуктивність процесу рафінування та вихід придатного продукту



Рівень готовності розробки.

Пропозиції до комерціалізації

IRL6, TRL6

Виготовлення чистих металів на замовлення

Охорона інтелектуальної власності

IPR3

Контактна інформація

Пугач Сергій Григорович, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, +38 057 335 68 43, +38 057 349 10 49, e-mail: pugach@kipt.kharkov.ua